

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成24年10月18日 (2012.10.18)

【公開番号】特開2010-141294(P2010-141294A)

【公開日】平成22年6月24日 (2010.6.24)

【年通号数】公開・登録公報2010-025

【出願番号】特願2009-241235(P2009-241235)

【国際特許分類】

H 0 1 L 27/12 (2006.01)

H 0 1 L 23/52 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 27/08 (2006.01)

H 0 1 L 21/8234 (2006.01)

H 0 1 L 27/088 (2006.01)

H 0 1 L 27/00 (2006.01)

H 0 1 L 21/02 (2006.01)

H 0 1 L 21/3205 (2006.01)

H 0 1 L 21/768 (2006.01)

H 0 1 L 23/522 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 27/12 C

H 0 1 L 29/78 6 1 3 Z

H 0 1 L 29/78 6 2 7 D

H 0 1 L 29/78 6 1 9 A

H 0 1 L 27/08 3 3 1 E

H 0 1 L 27/08 1 0 2 E

H 0 1 L 27/00 3 0 1 C

H 0 1 L 27/00 3 0 1 B

H 0 1 L 27/08 1 0 2 D

H 0 1 L 27/12 B

H 0 1 L 21/88 T

H 0 1 L 21/90 J

H 0 1 L 21/90 A

H 0 1 L 23/52 C

【手続補正書】

【提出日】平成24年9月5日 (2012.9.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 の基板上に第 1 の分離層を形成し、

前記第 1 の分離層上に第 1 の半導体素子層を形成し、

前記第 1 の半導体素子層及び前記第 1 の分離層に第 1 のレーザビームを照射することにより、前記第 1 の半導体素子層及び前記第 1 の分離層の一部を除去して開口部を形成し、

前記開口部に、前記第 1 の半導体素子層と電氣的に接続する第 1 の配線を形成し、
前記第 1 の半導体素子層上に第 1 の保護材を形成し、
前記第 1 の保護材中に、前記第 1 の配線に電氣的に接続する第 1 の電極を形成し、
前記第 1 の分離層に沿って、前記第 1 の基板と、前記第 1 の保護材が形成された前記第 1 の半導体素子層と、を分離し、
第 2 の基板上に第 2 の分離層を形成し、
前記第 2 の分離層上に第 2 の半導体素子層を形成し、
前記第 2 の半導体素子層及び前記第 2 の分離層に第 2 のレーザビームを照射することにより、前記第 2 の半導体素子層及び前記第 2 の分離層の一部を除去して開口部を形成し、
前記開口部に、前記第 2 の半導体素子層と電氣的に接続する第 2 の配線を形成し、
前記第 2 の半導体素子層上に第 2 の保護材を形成し、
前記第 2 の保護材中に、前記第 2 の配線に電氣的に接続する第 2 の電極を形成し、
前記第 2 の保護材上に、前記第 2 の電極と前記第 1 の配線が電氣的に接続されるように、前記第 1 の半導体素子層を貼り合わせ、
前記第 2 の分離層に沿って、前記第 2 の基板と、前記第 2 の保護材が形成された前記第 2 の半導体素子層及び前記第 1 の保護材が形成された前記第 1 の半導体素子層と、を分離することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 2】

請求項 1 において、

前記第 1 及び第 2 の保護材は、それぞれシート状繊維体に有機樹脂が含浸された構造体であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 において、

前記第 1 及び第 2 の電極は、それぞれ導電性樹脂であることを特徴とする半導体装置の作製方法。